



第十六届国际晶体生长会议征稿通知

第16届国际晶体生长会议暨第14届国际气相生长与外延会议 (The 15th International Conference on Crystal Growth (ICCG 16) in conjunction with the International Conference on Vapor Growth and Epitaxy (IVPE14)) 将于2010年8月8日至13日在北京国际会议中心举行。

国际晶体生长会议 (ICCG/IVPE) 是世界范围内晶体生长基础研究、晶体生长方法与技术、人工晶体材料原理结构与性能研究, 及薄膜材料制备表征与应用的最高级别的国际大型学术盛会。ICCG每三年举办一次, 自1966年在美国波士顿举办第一届ICCG起, 至今已经有44年的历史。2005年在法国的格勒诺布尔市举办, 2007年在美国的盐湖城举行, 2010年在北京举行。这是ICCG在我国举行的首届会议。

ICCG/IVPE由国际晶体生长组织主办, 委托某个国家晶体生长组织承办。本届大会是中国首次承办, 蒋民华院士与陈创天院士为ICCG16主席、王占国院士为ICVGE14主席、闵乃本院士为国际顾问委员会主席、陈创天院士为程序委员会主席、沈德忠院士为组织委员会主席。会议的主要议题有: 1. Fundamental of Crystal Growth (Theory, Simulation, Modeling, Growth Mechanism, Surface and Interfaces); 2. Growth of Crystalline Silicon and Photovoltaic Materials; 3. Narrow Gap and Compound Semiconductors; 4. Crystal Growth of Group III Nitride and Wide Band-gap Semiconductors; 5. Thin Film and Epitaxial Crystal Growth; 6. Crystal Growth of Laser and Nonlinear Optics (Including Laser Ceramics); 7. Growth of Scintillating, Ferroelectric, Piezoelectric and Multi-Functional Crystal; 8. Crystals for Thermoelectric, Magnetic and Electron-Correlated Systems; 9. New Crystalline Materials and Novel Growth Technology; 10. Bulk Crystal Growth of Miscellaneous Materials; 11. Industrial Crystallizations; 12. Organic and Biological Crystallization; 13. Photonic, Phononic Crystals and Fundamentals; 14. Nanocrystalline materials-dots, wires, nano-tubes, fullerenes and etc; 15. In-situ Measurement and Characterization of Crystal Growth; 16. Advanced Characterization of Crystals and Defects。

通过评审的会议论文将由Elsevier出版社的Journal of Crystal Growth出版。在会议过程中, 将评出优秀Poster奖和优秀图片奖。这次大会将为广大晶体生长、晶体物理、纳米材料、结构化学的科学家和年轻学者提供一个交流的平台, 欢迎踊跃参加。

会议期间, 将举行大型展览会, 欢迎人工晶体生产、加工设备、相关测试分析仪器、相关器件生产、各种软件、媒体与出版社等公司、厂商等参加展览。

同时, 第14届国际晶体生长夏季学校 (The Fourteenth International Summer School on Crystal Growth) 于2010年8月1-7日在大连理工大学举行。 (<http://www.isscg14.org.cn>), 由来自十几个国家的国际知名的晶体生长、表征、理论研究和晶体物理、纳米与生物结晶学的专家学者进行讲学, 欢迎广大研究生踊跃参加。

会议确定注册费为: 正式代表580美元/人(预注册); 680美元/人(现场注册); 学生代表: 400美元/人(预注册); 500美元(现场注册); 预注册时间不晚于7月10日。

由于我国国内各主要晶体研究单位已给ICCG-16/ICVGE-14财政与其他方面的全面支持。组委会决定: 凡中国硅酸盐学会会员或中国晶体学会会员在参会时均按以下注册费收取: 正式代表2400元/人(预注册); 2500元/人(现场注册); 学生代表1300元/人(预注册); 1500元/人(现

场注册).

会议摘要接收时间不晚于4月15日,预注册时间为7月10日前.欢迎晶体生长及相关领域同仁踊跃参加,具体信息请参看<http://iccg16.tipc.cn>

ICCG-16/ICVGE-14组织委员会

2010年3月12日

[① 返回首页](#)